

## CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----

## BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN

CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ

Mã hồ sơ:.....



(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ☒; Nội dung không đúng thì để trống: ☐)

Đối tượng đăng ký: Giảng viên ☒; Giảng viên thỉnh giảng ☐

Ngành: Vật lý; Chuyên ngành: Khoa học vật liệu

**A. THÔNG TIN CÁ NHÂN**

1. Họ và tên người đăng ký: Lê Thị Giang

2. Ngày tháng năm sinh: 26/03/1974; Nam ☐; Nữ ☒; Quốc tịch: Việt Nam;

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: ☒

4. Quê quán: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố: Xã Định Hải, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc xã, huyện, tỉnh): Lô C1 khu CN Tây Bắc Ga, Phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bru điện): Lê Thị Giang, Phó trưởng khoa Kỹ thuật Công nghệ, Trường ĐH Hồng Đức, 565 Quang Trung, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa

Điện thoại nhà riêng: 02373857531; Điện thoại di động: 0904988929;

E-mail: lethigiang@hdu.edu.vn

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan):

Từ năm 1995 đến năm 2000: Giáo viên tại Trường Trung học Sư phạm 12 + 2 Thanh Hóa

Từ năm 2000 đến năm 2012: Giảng viên tại Trường ĐH Hồng Đức

Từ năm 2012 đến năm 2020: Phó Trưởng khoa Kỹ Thuật Công nghệ tại Trường ĐH Hồng Đức

Chức vụ: Hiện nay: Phó Trưởng khoa Kỹ Thuật Công nghệ; Chức vụ cao nhất đã qua: Phó trưởng khoa

Cơ quan công tác hiện nay: Trường ĐH Hồng Đức

Địa chỉ cơ quan: 565 Quang Trung, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa

Điện thoại cơ quan:

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có):

8. Đã nghỉ hưu từ tháng ... năm ...

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có):

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ): Không

9. Trình độ đào tạo:

- Được cấp bằng ĐH ngày 01 tháng 08 năm 1995, ngành: Vật lý, chuyên ngành: Vật lý

Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Đại học Sư phạm Hà Nội I, Việt Nam

- Được cấp bằng ĐH ngày 23 tháng 12 năm 1998, ngành: Tin học, chuyên ngành: Tin học

Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam.

- Được cấp bằng ThS ngày 25 tháng 02 năm 2005, ngành: Vật lý, chuyên ngành: Vật lý chất rắn

Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Đại học Sư phạm Hà Nội I, Việt Nam.

- Được cấp bằng TS ngày 21 tháng 02 năm 2013, ngành: Khoa học Vật liệu, Vật lý, Hóa học và khoa học nano,,  
chuyên ngành: Khoa học Vật liệu

Nơi cấp bằng TS (trường, nước): ĐH AIX – Marseille, Cộng hòa Pháp

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày ... tháng ... năm ..., ngành: ...

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS cơ sở: Trường Đại học Hồng Đức

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Vật lý

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:

+ Màng mỏng bán dẫn pha loãng từ GeMn nhiệt độ Curie cao ứng dụng trong công nghệ điện tử spin.

+ Nghiên cứu hiệu ứng từ nhiệt và các tham số cận chuyển pha của các manganite

+ Nghiên cứu chế tạo một số vật liệu nhớ hình dạng màng mỏng.

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:

- Đã hướng dẫn (số lượng) 0 NCS bảo vệ thành công luận án TS;

- Đã hướng dẫn (số lượng) 5 HVCH/CK2/BSNT bảo vệ thành công luận văn ThS/CK2/BSNT (ứng viên chức danh GS không cần kê khai);

- Đã hoàn thành 2 đề tài NCKH cấp Nhà nước; 2 đề tài NCKH cấp Cơ sở; 2 đề tài NCKH cấp Khác;

- Đã công bố (số lượng) 24 bài báo KH, trong đó 11 bài báo KH trên tạp chí quốc tế có uy tín;

- Đã được cấp (số lượng) 0 bằng sáng chế, giải pháp hữu ích;

- Số lượng sách đã xuất bản 2, trong đó 2 thuộc nhà xuất bản có uy tín;

- Số lượng 0 tác phẩm nghệ thuật, thành tích thể dục, thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế.

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):

| TT       | Tên khen thưởng | Cấp khen thưởng | Năm khen thưởng |
|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Không có |                 |                 |                 |

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn hiệu lực của quyết định):

---

| TT       | Tên kỷ luật | Cấp ra quyết định | Số quyết định | Thời hạn hiệu lực |
|----------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Không có |             |                   |               |                   |

## B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ

### 1. Tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo (tự đánh giá):

Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của một nhà giáo: Có phẩm chất, tư tưởng, đạo đức tốt; Đáp ứng chuẩn nghề nghiệp theo vị trí việc làm; Có kỹ năng cập nhật, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; Bảo đảm sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp.

Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người giáo viên: Giảng dạy, giáo dục theo đúng mục tiêu, nguyên lý giáo dục, thực hiện đầy đủ và có chất lượng chương trình giáo dục. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, điều lệ nhà trường, quy tắc ứng xử của nhà giáo. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng, đối xử công bằng với người học; bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người học. Học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, nêu gương tốt cho người học.

### 2. Thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên \*:

- Tổng số 20 năm.

- Khai cụ thể ít nhất 6 năm học, trong đó có 3 năm học cuối tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ

(Căn cứ chế độ làm việc đối với giảng viên theo quy định hiện hành)

| TT | Năm học     | Số lượng NCS đã hướng dẫn |     | Số lượng ThS/CK2/BSNT đã hướng dẫn | Số đồ án, khóa luận tốt nghiệp ĐH đã HD | Số lượng giờ giảng dạy trực tiếp trên lớp |      | Tổng số giờ giảng trực tiếp/Số giờ quy đổi/Số giờ định mức |
|----|-------------|---------------------------|-----|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|
|    |             | Chính                     | Phụ |                                    |                                         | ĐH                                        | SDH  |                                                            |
| 1  | 2014 – 2015 |                           |     |                                    |                                         | 63                                        |      | 63/145/76                                                  |
| 2  | 2015 – 2016 |                           |     |                                    |                                         | 63                                        |      | 63/147/115                                                 |
| 3  | 2016 – 2017 |                           |     | 2                                  |                                         | 42                                        | 31.5 | 73,5/194,5/162                                             |

| 3 năm học cuối |             |  |  |   |  |     |     |                 |
|----------------|-------------|--|--|---|--|-----|-----|-----------------|
| 4              | 2017 – 2018 |  |  | 2 |  |     | 126 | 126/300/175,5   |
| 5              | 2018 – 2019 |  |  |   |  | 126 | 63  | 189/212/175,5   |
| 6              | 2019 – 2020 |  |  | 1 |  | 84  | 126 | 210/258,4/202,5 |

(\*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

- Từ 25/3/2015 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

### 3. Ngoại ngữ

#### 3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh

a) Được đào tạo ở nước ngoài ☒:

- Học ĐH ☐; Tại nước: ; Từ năm đến năm

- Bảo vệ luận văn ThS ☐ hoặc luận án TS ☒ hoặc TSKH ☐; Tại nước: Cộng Hòa Pháp năm 2012

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước ☐:

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: số bằng: ; năm cấp:

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài ☐:

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ:

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước):

d) Đối tượng khác ☐; Diễn giải:

#### 3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): Toefl iBT 62

#### 4. Hướng dẫn NCS, học viên CH, BSCK, BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng

| TT | Họ tên NCS hoặc HVCH/CK2/BSNT | Đối tượng |               | Trách nhiệm hướng dẫn |     | Thời gian hướng dẫn từ ... đến ... | Cơ sở đào tạo | Ngày, tháng, năm được cấp bằng/có quyết định cấp bằng |
|----|-------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|-----|------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
|    |                               | NCS       | HVCH/CK2/BSNT | Chính                 | Phụ |                                    |               |                                                       |
| 1  | Đỗ Thị Mỹ                     |           | X             | X                     |     | 12/2015 đến 10/2016                | ĐH Hồng Đức   | 24/03/2017                                            |

|   |                |  |   |   |  |                           |                   |            |
|---|----------------|--|---|---|--|---------------------------|-------------------|------------|
| 2 | Hoàng Văn Dũng |  | X | X |  | 12/2015<br>đến<br>10/2016 | ĐH<br>Hồng<br>Đức | 24/03/2017 |
| 3 | Phạm Văn Thái  |  | X | X |  | 01/2017<br>đến<br>11/2017 | ĐH<br>Hồng<br>Đức | 06/04/2018 |
| 4 | Lường Quốc Dục |  | X | X |  | 01/2017<br>đến<br>11/2017 | ĐH<br>Hồng<br>Đức | 06/04/2018 |
| 5 | Trần Thị Thu   |  | X | X |  | 02/2019<br>đến<br>10/2019 | ĐH<br>Hồng<br>Đức | 28/02/2010 |

*Ghi chú:* Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai số lượng NCS.

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên

| TT                            | Tên sách                                                         | Loại sách<br>(CK, GT, TK, HD) | Nhà xuất bản và năm xuất bản | Số tác giả | Chủ biên | Phần biên soạn (từ trang ... đến trang) | Xác nhận của cơ sở GDĐH (số văn bản xác nhận sử dụng sách) |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------|----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ |                                                                  |                               |                              |            |          |                                         |                                                            |
| 1                             | Tổng hợp một số màng đa lớp Ge/GeMn cho các ứng dụng spintronics | CK                            | GDVN, năm 2020               | 1          | CB       |                                         | 822 /QĐ - ĐHHĐ                                             |
| 2                             | Chapter: Self-assembly of GeMn nanocolumns in GeMn thin films    | CK                            | IntechOpen, năm 2020         | 1          | MM       | (Cả chương)                             | 822 /QĐ - ĐHHĐ                                             |

Trong đó, số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản sau PGS/TS: 2

*Lưu ý:*

- Tách thành 2 giai đoạn: Trước và sau khi bảo vệ luận án TS đối với ứng viên chức danh PGS; trước và sau khi được công nhận chức danh PGS đối với ứng viên chức danh GS;
- Chi kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có).

**Các chữ viết tắt:** CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang.... đến trang..... (ví dụ: 17-56; 145-329).

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu

| TT                            | Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ (CT, ĐT...)                                                                                                                 | CN/PCN/TK | Mã số và cấp quản lý          | Thời gian thực hiện       | Thời gian nghiệm thu (ngày, tháng, năm) / Kết quả |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ |                                                                                                                                                                |           |                               |                           |                                                   |
| 1                             | Nghiên cứu, tổng hợp các màng đa lớp Ge1-xMnx /Ge có cấu trúc dạng cột nano và nhiệt độ Curie cao cho các ứng dụng spintronics.                                | CN        | 103.02-2013.66, cấp Nhà nước  | 01/03/2014 đến 01/03/2016 | 07/7/2016/<br>Đạt                                 |
| 2                             | Nghiên cứu chế tạo màng mỏng epitaxy Germani trên Silic có ứng suất căng và pha tạp điện tử với mật độ cao nhằm ứng dụng trong lĩnh vực quang điện tử tích hợp | TK        | 103.02-2015.106, cấp Nhà nước | 01/05/2016 đến 01/05/2019 | 19/6/2019<br>Đạt                                  |
| 3                             | Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ pha tạp carbon lên cấu trúc pha Mn5Ge3 bằng phương pháp epitaxy chùm phân tử                                                  | CN        | ĐT – 2018 - 43, cấp Cơ sở     | 30/11/2018 đến 30/11/2019 | 06/5/2020 /<br>Xuất sắc                           |



|   |                                                                                                                                                          |    |       |                                       |                              |    |                         |      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------------------------------------|------------------------------|----|-------------------------|------|
| 1 | Long range Mn segregation and intermixing during subsequent deposition of Ge capping layers on Mn <sub>5</sub> Ge <sub>3</sub> /Ge(111) heterostructures | 10 | Không | Thin Solid Film                       | Q2 - ISI<br><b>IF: 1.888</b> | 7  | 518 ,<br>S266 -<br>S269 | 2010 |
| 2 | Mn segregation in Ge/Mn <sub>5</sub> Ge <sub>3</sub> heterostructures<br>The role of surface carbon adsorption                                           | 7  | Không | Appl. Phys. Lett.                     | Q1 - SCI<br><b>IF: 3.59</b>  | 21 | 99 ,<br>151908          | 2011 |
| 3 | The effects of Mn concentration on structural and magnetic properties of Ge <sub>1-x</sub> Mn <sub>x</sub><br>Diluted magnetic semiconductors            | 8  | Có    | Journal of Physics: Conference Series | Q3 - Scopus                  | 3  | 292 ,<br>012012         | 2011 |



|   |                                                                                                                                      |    |       |                                       |                              |   |                |      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------------------------------------|------------------------------|---|----------------|------|
| 4 | An unusual phenomenon of surface reaction observed during Ge overgrowth on Mn <sub>5</sub> Ge <sub>3</sub> /Ge(111) heterostructures | 8  | Không | NEW JOURNAL OF PHYSICS                | Q1 - SCI<br><i>IF: 3.75</i>  | 7 | 14 ,<br>103020 | 2012 |
| 5 | Suppression of Mn segregation in Ge/Mn <sub>5</sub> Ge <sub>3</sub> heterostructures induced by interstitial carbon                  | 10 | Không | Thin Solid Film                       | Q2 - ISI<br><i>IF: 1.888</i> | 4 | 520 ,<br>3410  | 2012 |
| 6 | Growthvcompetition between semiconducting Ge <sub>1-x</sub> Mnx nanocolumns and metallic Mn <sub>5</sub> Ge <sub>3</sub> clusters    | 8  | Có    | Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. | Q1 - Scopus                  | 7 | 3 ,<br>205007  | 2012 |

Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ

|   |                                                                                                                   |    |       |                                                     |                              |    |                        |      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----|------------------------|------|
| 7 | Molecular-beam epitaxial growth of tensile-strained and n-doped Ge/Si(001) films using a GaP decomposition source | 15 | Không | Thin Solid Film                                     | Q2 - ISI<br><b>IF: 1.888</b> | 10 | 557 ,<br>70-75         | 2014 |
| 8 | Chemical composition of High – TC Ge <sub>1-x</sub> Mnx nanocolumns growth on Ge(001) substrates                  | 2  | Có    | Communications in Physics                           |                              |    | 24 , 2,<br>163-<br>169 | 2014 |
| 9 | Segregation of Manganese Atoms during the Growth of Ge <sub>1-x</sub> Mnx Nanocolumns on Ge (001)                 | 2  | Có    | VNU Journal of Science:<br>Mathematics –<br>Physics |                              |    | 30 , 2,<br>10-17       | 2014 |

|    |                                                                                                                 |   |    |                                                                                                                                         |                              |   |                  |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---|------------------|------|
| 10 | Study the kinetics of phase formation of Ge <sub>1-x</sub> Mnx diluted magnetic semiconductors grown on Ge(001) | 2 | Có | Proceedings of The 3rd academic conference on natural science for master and PhD. Students from ASIAN countries ISBN: 978-604-913-088-5 |                              |   | , 472-481        | 2014 |
| 11 | New insight into the kinetic formation of high-TC GeMn nanocolumns                                              | 2 | Có | Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm KH&CN Việt nam                                                                             |                              |   | 52 , 3B, 30-37   | 2014 |
| 12 | Direct structural evidences of epitaxial growth Ge <sub>1-x</sub> Mnx nanocolumn bi-layers on Ge(001)           | 1 | Có | Materials Sciences and Applications                                                                                                     | - Hệ thống CSDL quốc tế khác |   | 6 , 533-538      | 2015 |
| 13 | Vertical self-organization of Ge <sub>1-x</sub> Mnx nanocolumn multilayers grow on Ge(001) substrates           | 2 | Có | Modern Physics Letters B                                                                                                                | Q3 - ISI<br><b>IF: 0.94</b>  | 2 | 30 , 20, 1650269 | 2016 |

|    |                                                                                                                                                                            |   |       |                                        |  |  |                  |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------------------------------------|--|--|------------------|------|
| 14 | Preliminary study on GeTe-SbTe and Sm-B topological insulators                                                                                                             | 7 | Không | Hong Duc University Journal of Science |  |  | 8 , E3, 5-12     | 2017 |
| 15 | Nghiên cứu tính chất quang của màng silica-titania-alumina pha tạp Er <sup>3+</sup> ứng dụng trong dẫn sóng phẳng                                                          | 2 | Không | Tạp chí KH&CN ĐH Đà Nẵng               |  |  | 124 , 3, 104-107 | 2018 |
| 16 | Ảnh hưởng của nồng độ ion Al <sup>3+</sup> và điều kiện công nghệ tới tính chất quang của màng silica – titania pha tạp ion Er <sup>3+</sup> ứng dụng trong quang dẫn sóng | 2 | Không | Tạp chí khoa học ĐH Hồng Đức           |  |  | 39, 120-129      | 2018 |

|    |                                                                                                                                                            |   |       |                                                                     |                              |  |                    |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|--------------------|------|
| 17 | Critical Exponents and magnetocaloric Effect in $\text{La}_{0.7}\text{Sr}_{0.3}\text{Mn}_{1-x}\text{Ti}_x\text{O}_3$ ( $x = 0$ and $0.05$ ) Compounds      | 7 | Không | Journal of Electronic Materials                                     | Q2 - ISI<br><b>IF: 1.676</b> |  | 48,<br>1446-1455   | 2019 |
| 18 | Ảnh hưởng của định hướng để lên sự hình thành các màng GeMn                                                                                                | 2 | Có    | Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐHTN                                   |                              |  | 204 ,<br>11, 71-79 | 2019 |
| 19 | Tương quan giữa tham số trật tự và hiệu ứng từ nhiệt trong Perovskite $\text{La}_{0.7}\text{Sr}_{0.3}\text{Mn}_{1-x}\text{Cu}_x\text{O}_3$ ( $x=0-0.06$ ). | 2 | Không | Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2019 |                              |  | , 161-169          | 2019 |
| 20 | Effect of carbon on structural and magnetic properties of $\text{Ge}_{1-x}\text{Mn}_x$ nanocolumns                                                         | 3 | Có    | Bull. Mater. Sci.                                                   | Q2 - ISI<br><b>IF: 1.3</b>   |  | 43 ,<br>103        | 2020 |

|    |                                                                                                                                                                             |   |    |                                       |             |  |                  |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---------------------------------------|-------------|--|------------------|------|
| 21 | Gaining insights into the formation of high Curie temperature GeMn nanocolumns: the effect of substrate crystalline orientation on their structural and magnetic properties | 3 | Có | Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. | Q1 - Scopus |  | 11 , 3,          | 2020 |
| 22 | Preliminary study the magnetic properties of GeMn nanocolumn /Ge multilayers                                                                                                | 2 | Có | Materials Sciences and Applications   |             |  | 11 , 7,          | 2020 |
| 23 | Ảnh hưởng của nhiệt độ lắng đọng lớp phủ Ge lên cấu trúc của các màng đa lớp Ge/ Mn <sub>5</sub> Ge <sub>3</sub> /Ge(111)                                                   | 1 | Có | Tạp chí khoa học ĐH Sư phạm Hà Nội 2  |             |  | , chấp nhận đăng | 2020 |

|    |                                                                                                                                        |   |    |                              |  |  |                  |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------------------------------|--|--|------------------|------|
| 24 | Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ pha tạp carbon lên cấu trúc của các màng Mn <sub>5</sub> Ge <sub>3</sub> được chế tạo trên đế Ge(111) | 1 | Có | Tạp chí khoa học ĐH Hồng Đức |  |  | , chấp nhận đăng | 2020 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------------------------------|--|--|------------------|------|

- Trong đó, số lượng bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín mà UV là tác giả chính sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS: 3

*Lưu ý:* Tách thành 2 giai đoạn: Trước và sau khi bảo vệ luận án TS đối với ứng viên chức danh PGS; trước và sau khi được công nhận chức danh PGS đối với ứng viên chức danh GS.

#### 7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích

| TT       | Tên bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích | Tên cơ quan cấp | Ngày tháng năm cấp | Tác giả chính/ đồng tác giả | Số tác giả |
|----------|------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|------------|
| Không có |                                                |                 |                    |                             |            |

- Trong đó, các số TT của bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS:

#### 7.3. Giải thưởng quốc gia, quốc tế:

| TT       | Tên giải thưởng | Cơ quan/tổ chức ra quyết định | Số quyết định và ngày, tháng, năm | Số tác giả |
|----------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------|
| Không có |                 |                               |                                   |            |

- Trong đó, các số TT giải thưởng quốc gia, quốc tế sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS:

#### 7.4. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế

| TT | Tên tác phẩm nghệ thuật, thành tích | Cơ quan/tổ chức công nhận | Văn bản công nhận (số, ngày, tháng, năm) | Cấp quốc gia/Quốc tế | Số tác giả |
|----|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|----------------------|------------|
|    |                                     |                           |                                          |                      |            |

Không có

- Trong đó, tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế:

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa vào áp dụng thực tế:

| TT | Chương trình đào tạo hoặc chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ | Vai trò  | Cơ sở giáo dục đại học |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 1  | Chương trình đào tạo Thạc sĩ Vật lý chất rắn                                   | Tham gia | ĐH Hồng Đức            |
| 2  | Đại học Công nghệ Kỹ thuật điện - Điện tử                                      | Chủ trì  | ĐH Hồng Đức            |

9. Các tiêu chuẩn còn thiếu so với quy định cần được thay thế bằng bài báo khoa học quốc tế uy tín\*:

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm: thiếu (số lượng năm, tháng):

b) Hoạt động đào tạo

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm: thiếu (số lượng năm, tháng):

- Giờ giảng dạy

+ Giờ giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ: thiếu (năm học/số giờ thiếu):

+ Giờ chuẩn giảng dạy không đủ: thiếu (năm học/số giờ thiếu):

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT:

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (UV chức danh GS) ☐

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu:

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT (UV chức danh PGS) ☐

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng ThS/CK2/BSNT bị thiếu:

c) Nghiên cứu khoa học

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (UV chức danh GS) ☐

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu:

- Đã chủ trì không đủ 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (UV chức danh PGS) ☐

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu:

- Không đủ số CTKH là tác giả chính:

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được: 03 CTKH ☐; 04 CTKH ☐

Đề xuất sách CK/chương sách XB quốc tế thay thế cho việc UV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định:

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được: 02 CTKH ☐

Đề xuất sách CK/chương sách XB quốc tế thay thế cho việc UV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy



định:

*(\*) Các công trình khoa học thay thế không được tính vào tổng điểm.*

**C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH:**

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP. Thanh Hóa, ngày 30 tháng 06 năm 2020

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)